5. 研究室紹介(第38回)

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 丸山研究室

1. 研究室の概要

東京都文京区にある本郷キャンパスの工学系研究科機械工学専攻でフラーレンやナノチューブの研究を進めている[1].最近のナノテクノロジーブームのおかげで、ナノチューブを機械工学専攻での研究対象としても特に奇異に思われることは少なくなったが、ちょっと前までは、どうして機械工学専攻でフラーレン・ナノチューブなのかという質問をよくいただいた.このあたりの事情は本誌の第16回研究室紹介[2]に詳細に述べているので、今回はライス大学のSmalley教授のところに長期出張に出かけたことがきっかけであるとの記述にとどめたく思う.機械工学専攻では庄司・丸山研究室として、庄司正弘教授の講座に所属している.平成10年度から平成12年度までは工学部附属総合試験所に移動して機械方面研究室(丸山研究室)を名乗り、平成13年度からは再び機械工学専攻に戻っている.平成14年度のメンバーは図1の通りである(4



図1.研究室メンバー(平成14年4月). 左から渡辺美和子(秘書),木村達 人(PD),井上修平(D3),千足昇平(M2),澁田靖(D2),丸山茂夫(助 教授),手島一憲(M2),小川哲(M1),宮内雄平(M1),谷口祐規(M1). 写っていないが井上満(助手).

年生はまだ配属されてない).本年の研究テーマはほぼ全て単層ナノチューブ関 連であり、意図的に学生の半分は実験的なテーマ、半分は分子動力学法のテー マとしている.

2. 研究テーマ

フラーレン・ナノチューブ関係の研究は、1989年に Rice 大学 Smalley グルー プに長期出張してからスタートしている.最初はフーリエ変換イオンサイクロ トロン共鳴(Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance, FT-ICR)質量分析装置を用 いたクラスターの研究であり[3,4],当時はフラーレンもクラスターと呼ばれてい たが, Krätschmer-Huffman のフラーレン大量合成の直後から, フラーレン生成に 取りかかった[5].帰国後は、比較的簡単に実験が可能なアーク放電装置を用い たフラーレン生成を行うとともに、分子動力学法を用いたシミュレーションに よって実験と比較するような研究を試みた.ナノチューブに関しても、1992年 の夏に再び Smalley グループを訪ねたときに、真空容器内に数 Torr の炭化水素 を満たし、炭素繊維先端にレーザー光を照射してナノチューブを成長させよう とする実験装置を設計している. そのときは, SEM も TEM もなく電界放出から ナノチューブ生成を検証しようとした無謀な実験であったが、今であれば、金 属触媒と炭素源を工夫すれば、同じ装置で単層ナノチューブを生成させられる ように思う. Smalley グループよりは相当に遅れているが、結果的に、クラスタ ー、フラーレン、金属内包フラーレン、単層ナノチューブと研究対象の原子数 を着実に増やしてきて、一貫してこれらを生成することと生成メカニズムにこ だわってきた[6-10]. 大まかには、アーク放電装置、レーザーオーブン装置、触 媒 CVD 装置などで実際に生成する実験, レーザー蒸発クラスター源付き FT-ICR 質量分析装置を用いて前駆体クラスターを探る実験、分子動力学法シミュレー ションによる予測である.最近では、ナノチューブの応用と関係して、水素吸 蔵特性や熱伝導特性などの分子動力学法シミュレーションも行っている.水素 吸蔵や熱伝導などの研究テーマとなると、機械工学専攻でナノチューブの研究 をしても怪しまれなくなったどころか、機械系の学会においても相当数のナノ チューブ関係の研究が発表されるようになっており、驚きを隠せないでいる.

3. 研究成果の紹介

3-1. アルコール・触媒 CVD 法による単層ナノチューブの生成[11]

単層カーボンナノチューブ(SWNT)の生成メカニズムと関連して、最も純粋な 試料の生成が可能なレーザーオーブン装置(図2)で SWNT の生成を行ってき た.図2の装置は総合試験所で河野正道助手(現:産総研)が中心となり、都 立大学阿知波研の装置を参考にして設計したものである.その後、たとえば HiPcoなどの触媒 CVD(CCVD)で相当に高純度の単層ナノチューブが生成される



図2 レーザーオーブン SWNT 生成装置



図3 アルコール・CCVD 装置

ようになっていることもあり,昨年度か らレーザーオーブン装置をほぼそのま ま触媒 CVD 装置として使っている(図 3).



図4 アルコール・CCVD 法によっ て生成した SWNT の TEM 像.

C₆₀を炭素源とした CCVD によるナノチューブ生成を試みていて,偶然,エタ ノールを炭素源として極めて高純度の単層ナノチューブの生成が可能であるこ とがわかった[11]. 触媒に関しては名古屋大学篠原研の方法によって,Y型のゼ オライトに Fe/Co を担持したものとし,電気炉にセットして,アルゴン流中で 昇温後,いったん真空にして,アルコールを流す.炭化水素の場合と異なり, 極めて純粋な単層ナノチューブが生成される.電気炉温度を 800℃とし,エタノ ールを用いて 10 分間反応させた直後の TEM 像を図4に示す.アモルファスカ ーボン, MWNT,炭素ナノ粒子,金属粒子などが全く見あたらずに,SWNT の束 のみが観察される.また,アルコール CCVD によって,炭化水素を炭素源とす るよりも低温での SWNT 合成が可能であり,メタノールを用いて 550℃におい ても相当量の SWNT が合成できている[11].

SWNT の評価にはラマン分光が必須となっており,図5のマクロラマン分光 装置を SWNT 生成装置のとなりに自作している.これも河野正道助手を中心に 都立大の片浦先生のアドバイスを頂きながら立ち上げたものである.アルゴン



図5 ラマン分光装置

イオンレーザー(波長 488nm)を励起 光とし、プラズマラインフィルターを 通過後に試料に集光し、後方散乱のラ マン光はノッチフィルターで励起光 をカットして 30cm のシングルモノク



図6 SWNTの共鳴ラマン散乱(励起波 長488nm).

ロメータ (Chromex 500is2-0419) に入れ, CCD (Andor DV401-FI) で検出して いる.

図6にラマン分光の測定例をエタノール・CCVD 法で生成した試料とレーザ ーオーブン法によって生成した試料を比較して示す.1590cm⁻¹付近のグラファ イト由来のGバンド,1350cm⁻¹付近に見られるプロードなDバンド,SWNT に 特徴的な150~300 cm⁻¹付近のブリージングモード(RBM)のいずれからもレーザ ーオーブン法で生成した試料は典型的な SWNT の特徴を示している.一方, CCVD で生成される SWNT は、より細く広めの直径分布を有し、488nm の励起



図7 環境制御型 SPM 装置



図8 精製 SWNT バンドルの AFM 像

光を用いた場合には、細い金属 SWNT (240~300cm⁻¹) が観察されている.この ため、金属 SWNT の束に特有の Breit-Wigner-Fano (BWF)と呼ばれるピークも観 察されている.励起光のエネルギーに対応した Kataura プロットによる検討結果 を研究室の HP にのせている[12].

工学部総合試験所の TEM および機械工学専攻中尾研究室の SEM を借用した 電顕観察とともに,図7の環境制御型の AFM/STM によってナノチューブの観 察とともにハンドリングも目指している.図8は,レーザーオーブン法で生成 した SWNT を H₂O₂ 水溶液で生成した後に超音波分散させてシリコン(001)面に のせて測定した AFM イメージである.強力な超音波分散によっても,からまっ たバンドルをほどくのは容易でな い.

3-2. FT-ICR によるナノチュー ブ前駆体クラスターの質量分析

レーザーオーブン法やアルコー ルCCVD法によるSWNT生成実験 によって,SWNTの生成メカニズ ムに迫れる部分もあるが,基本的 には結果しか観察できず,反応の 途中段階については,想像するし かない.そこで,かつてフラーレ ンや金属内包フラーレン[13,14]の 生成機構を追いかけた FT-ICR 装 置によってナノチューブ前駆体クラ



図10 Ni/Co 添加黒鉛材料から負 イオンクラスター



図 9 レーザー蒸発クラスターソース直接導入 FT-ICR 質量分析装置



図11 Ni 付きおよび Co 付き炭素ク ラスターの NO との化学反応

スターを捕らえるべく実験を行っている[15-17]. FT-ICR 実験装置の基本設計は Smalley グループ[4]のものとほとんどかわらず、レーザー蒸発と超音速膨張によ って様々な固体材料のクラスターを生成し、クラスターイオンを 6 テスラの超 電導磁石の中に数分間に渡って閉じこめ、極めて高分解能の質量分析とトラッ プをしている間の化学反応やレーザー照射実験ができる.

図10は、Ni/Co をそれぞれ 0.6%添加した黒鉛材料をレーザー蒸発させて FT-ICR で測定した質量スペクトルを炭素や金属の天然同位体分布から再現した スペクトルと比較したものである. 負イオンの質量分析によって C₆₀程度の大き さの炭素クラスターに Ni や Co が 1~3 個加わったクラスターの存在がわかる. 特に図10で注目すべきは、同位体を分けて考えれば C や H の質量は原子質量 単位(amu)でおおよそ整数となるが、Ni や Co などでは、相対論効果で質量が 0.03amu ほどずれる. FT-ICR では、図10に示すように、この差が測定できる ために、例えばちょうど 720amu のシグナルが、 12 C₆₀のものと金属原子を1 個含 むシグナルとに分裂している.

FT-ICR による化学反応実験の例を図11に示す.(a)が反応前の質量スペクトル,(b)が2秒の反応後,(c)が10秒の反応後である.この場合は,Ni,Coの付いた炭素クラスターの割合が少なく解釈が簡単ではないが,Ni,Coのいずれかを含む炭素クラスターが極めて定圧(10⁻⁷ Torr)のNOとの衝突によって反応しており,La,Y,Sc などの金属内包型フラーレンを作る金属で行った同様の実験と極めて対照的な結果となる.

3-3. ナノチューブ生成過程の分子動力学

フラーレン C₆₀ がサッカーボール型の幾何学形状を自発的にとるということのメカニズムを探ることから始めて、分子動力学法によって、いったんは蒸発



図12 分子動力学法による SWNT 前駆 図13 分子動力学法により得られ 体クラスターのシミュレーション た不完全ナノチューブ.

ー応は再現し、フラーレン生成モデルを検討してきた[18,19]. その後、金属と炭 素クラスターのポテンシャルなども作成し、金属内包フラーレンの生成過程な ども検討してきた[20-22]. アーク放電法やレーザーオーブン法での実験条件か ら金属内包フラーレンを生成していた条件で、金属の種類を変えれば SWNT が 生成されることになる. 同じように、金属原子として Ni を選びこれと炭素原子 とがどの様なクラスターを経てナノチューブに成長するのかを分子動力学法シ ミュレーションで検討している[23,24]. Ni 原子を1 at. %程度含む場合に炭素ク ラスターがどの様に成長するかを計算したのが図12である. これまでの計算 と同様にいったんは全て蒸気になったと仮定している. 炭素数が 50-100 程度の クラスターまで成長した段階で観察されるクラスターは、炭素原子ができるだ けケージ状になろうとしているが、1個か2個の Ni 原子が妨害しているという ものであった. 金属原子の数から確率的に当然の比率でのクラスターであり、 ある程度アニーリングする時間があるとすると、このサイズでのクラスターの 形状としては極めて自然であると考えられ、シミュレーションをする必要があ ったかさえ疑問に残る. さらに、FT-ICR による実験の結果とも良く符合する.

さて、その後のこれらのクラスター同士の反応の進行をさらに分子動力学法 で検討した結果が図13である.このシミュレーションにおいては、図12の 場合よりもさらに大きな時間圧縮をしており、シミュレーション時間では図1 2から4.5ns後であるが、現実の時間スケールでは数msに対応すると予想され る.このため、クラスター構造のアニーリングは全く追いついていないが、ア スペクト比の大きい構造となり、金属原子は、SWNTの胴体のように6員環の みで構成された部分は好まず両端などの不安定な部分に集まりだしている.

3-4. ナノチューブによる水素吸蔵の分子動力学



図14 SWNTによる水素吸蔵の分子動力学法シミュレーション[26].

ナノチューブが極めて高い水素吸蔵能をもつとの実験的報告に触発されて, 様々な条件での水素吸蔵実験や分子シミュレーションによるメカニズム解明が 盛んに試みられている.一部の実験に関しては測定上の問題が示唆されるとと もに,少なくとも物理吸着による理論によっては,常温での極めて高い水素吸 蔵は説明できない.特に原子レベルから構造の明らかな SWNT を中心に分子動 力学法シミュレーションによって理論的な検討を行っている[25,26].

例として図14にカイラル指数(10,10)(直径約1.36 nm)の幾何学構造をもつ7 本のSWNTの束に77K,10MPaで水素を吸着させた様子(図14(a))とそのとき のポテンシャルエネルギー分布(図14(b)(c))を示す.計算手法としては,水素 分子間,水素-炭素間,炭素原子間のポテンシャルをすべてLennard-Jones(12-6) ポテンシャルで近似している.直径約1.36 nmの(10,10)ナノチューブの場合には, チューブ内部に比較的強い吸着層が1層できるとともに,チューブ間のインタ ースティシャルサイトで比較的ポテンシャルが低くなる.残念ながら,常温に おけるSWNTの水素吸蔵量はさほど大きくないが[26],炭素ナノチューブを用 いることによって従来にない興味深い吸着の物理が展開されつつあることは確 かである.

3-5. ナノチューブの熱伝導に関する分子動力学[27-29]

SWNTsのチューブ軸方向の熱伝導率は、ダイヤモンドを越えて物質の中で最 大となると予想され、極めて特異な熱デバイス開発の可能性を秘めている.さ らに、分子動力学法によって固体内の熱伝導や界面熱抵抗をフォノンの伝搬と 関連して解析する第一段階のモデル材料としても一次元的幾何学形状の SWNT は最適である.従来のナノチューブに関する分子動力学法計算は、軸方向の周

期境界条件を仮定し,非平衡分子動力 学法(NEMD)や Green-Kubo の公式に基 づく平衡分子動力学法によって無限長 における熱伝導率を外挿するような計 算であり,その外挿には疑問の残る部 分もある.そこで,境界条件のはっき りとした有限長の SWNT の熱伝導につ いて, Brenner ポテンシャルを用いた分 子動力学法シミュレーションを行って いる[27-29].ナノチューブ両端の温度 を Langevin 法で制御し,その制御量と 温度分布より熱伝導率を求めた.図1 5に示すように,(5,5),(8,8)と(10,10)の 300K における熱伝導率は,長さ404nm





までの結果ではチューブ長さの 0.1~0.3 乗に比例して増大し発散する結果となった. 当然, ナノチューブの長さ L がある程度以上となれば一定の熱伝導率に 収束すると考えられるが, ナノチューブを用いたデバイスなどでは数 100nm 程 度の長さでの利用が考えられ, 有限長における熱伝導特性は極めて重要である. このような熱伝導率の発散は, 1 次元系のモデル計算で熱伝導率が長さの 0.35 乗や 2/5 乗に比例して発散すると議論されているものと類似で, ナノチューブの 1 次元性が強く現れているものと解釈できる[28,29].

さらに、分子動力学法シミュレーションとフォノンを用いた解析とをつなげ る第一歩として、速度のパワースペクトルによるフォノンの状態密度、および 分散関係を求めるために各原子の平均位置 r からのずれ r'を実空間 z 方向の座 標と時間の関数として、2 次元時空間 Fourier 変換を求めた. 図16に(5,5) SWNT について長さ 101nm の場合の結果を示す. 図16(a)、(b)、(c)はそれぞれ半径方向 r、接線方向6、軸方向 z の変位成分から求めた分散関係とそれぞれの方向の速度 成分から求めた状態密度である. 図16(d)は、ダイナミカルマトリクスを解い て求めた理論的な結果である. このように、分子動力学法による直接的なフォ ノンの表現が得られると、欠陥、バンドル、同位体効果などのある場合のラマ ン分光結果などの解釈にもつなげられる.

3-6. その他の分子動力学シミュレーション

SWNT 内外への水素などの物理吸着, ピーポッドの形成(図17), ピーポッド内のフラーレンの構造, ピーポットからの2層ナノチューブ生成, SWNT バンドルなどの種々の分子動力学法シミュレーションを行っている. 例えば, ピーポッドからの2層ナノチューブ(DWNTs)生成過程の分子動力学法シミュレートでは, 適切な温度条件により単層ナノチューブに内包された5つの C₆₀が, ポリマー, ピーナッツ型, 楕円構造から2層ナノチューブへと変化する過程を



図17 ピーポットの形成



図18 SWNT 中の水クラスターの 挙動

再現している.

また、図18は、SWNTの中に水の クラスターが入った場合の分子動力学 法シミュレーションのスナップショッ トである.例えば、固体面上での気体 分子の凝縮過程[30]や白金表面に接す

る水液滴の構造[31]などを分子動力学法シミュレーションによって検討しており,固体面のぬれや接触角などに関する分子レベルからの理解を進めている. SWNTのチューブ内の狭い空間でのぬれ,相変化,流動,熱流動などは,理論的に極めて興味深い.もちろん,これらの検討は,吸着の分野などでミクロ孔内現象として理論的な検討がされているが,幾何学構造が均一に決まる SWNTの場合には理論と直接に対応する実験も非現実的ではない点が特色である.

参考文献

- (1) http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/nanotube-j.html.
- (2) 丸山茂夫, 季刊フラーレン, (1996), vol. 4, no. 4, pp. 106-113.
- (3) S. Maruyama, M. Y. Lee, R. E. Haufler, Y. Chai and R. E. Smalley, Z. Phys. D, (1991), vol. 19, pp. 409-412.
- (4) S. Maruyama, L. R. Anderson and R. E. Smalley, Rev. Sci. Instrum., (1990), vol. 61, no. 12, pp. 3686-3693.
- (5) R. E. Haufler, Y. Chai, L. P. F. Chibante, J. Conceicao, C. Jin, L.-S.Wang, S. Maruyama and R. E. Smalley, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., (1991), vol. 206, pp. 627-638.
- (6) 丸山茂夫, 化学工学, (1992), vol. 56, no. 6, pp. 422-423.
- (7) 丸山茂夫, 化学, (1997), vol. 52, no. 5, pp. 20-22.
- (8) 丸山茂夫,季刊化学総説(炭素第三の同素体フラーレンの化学),(1999),vol.
 43, pp. 10-19.
- (9) 丸山茂夫, 放射線化学, (2002), vol. 73, in press.
- (10) 丸山茂夫, カーボンナノチューブ, 情報機構, (2002) in press.

- (11) S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi and M. Kohno, Science (2002), submitted.
- (12) http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama/kataura/kataura.html.
- (13) S. Maruyama, M. Kohno and S. Inoue, Fullerene 2000: Chemistry and Physics of Fullerenes and Carbon Nanomaterials, (2000), pp. 309-319.
- (14) S. Maruyama, Y. Yamaguchi, M. Kohno and T. Yoshida, Fullerene Sci. Tech., (1999), vol. 7, no. 4, pp. 621-639.
- (15) S. Maruyama, Perspectives of Fullerene Nanotechnology, (2002), pp. 131-142.
- (16) M. Kohno, S. Inoue, R. Kojima, S. Chiashi and S. Maruyama, Physica B, (2002), in press.
- (17) M. Kohno, S. Inoue, A. Yabe and S. Maruyama, Micro. Themophys. Eng., (2002), submitted.
- (18) Y. Yamaguchi and S. Maruyama, Chem. Phys. Lett., (1998), vol. 286, pp. 336-342.
- (19) S. Maruyama and Y. Yamaguchi, Chem. Phys. Lett., (1998), vol. 286, pp. 343-349.
- (20) Y. Yamaguchi and S. Maruyama, Euro. Phys. J. D, (1999), vol. 9, pp. 385-388.
- (21) Y. Yamaguchi and S. Maruyama, Fullerenes: Recent Advances in the Chemistry and Physics of Fullerenes and Related Materials, (1999), vol. 7, pp. 640-646.
- (22) S. Maruyama, Endofullerenes: A New Family of Carbon Clusters, (2002), in press.
- (23) S. Maruyama and Y. Shibuta, Molecular Crystals and Liquid Crystals, (2002), in press.
- (24) Y. Shibuta and S. Maruyama, Physica B, (2002), in press.
- (25) S. Maruyama and T. Kimura, Proc. ASME Heat Transfer Division 2000, Orlando, (2000), vol. 2, pp. 405-409.
- (26) 丸山茂夫, 応用物理, (2002), vol. 71, no. 3, pp. 323-326.
- (27) S. Maruyama, S.-H. Choi, Therm. Sci. Eng., (2001), vol. 9, no. 3, pp. 17-24.
- (28) S. Maruyama, Physica B, (2002), in press.
- (29) S. Maruyama, Micro. Themophys. Eng., (2002), submitted.
- (30) T. Kimura and S. Maruyama, Micro. Themophys. Eng., (2002), vol. 6, no. 1, pp. 3-13.
- (31) T. Kimura and S. Maruyama, Proc. 12th Int. Heat Transfer Conf., (2002), in press.